



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

طرح n-MOSFET به کمک گیت ساختگی برای یک مدار
ادغام یافته مقاوم به تابش

عنوان انگلیسی مقاله :

Dummy Gate-Assisted n-MOSFET Layout for a
Radiation-Tolerant Integrated Circuit



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

V. CONCLUSION

A new radiation-tolerant n-MOSFET layout termed a DGA n-MOSFET layout was evaluated for a radiation-tolerant circuit design. For practical purposes, the proposed DGA n-MOSFET layout does not have limitations with regard to the W/L ratio and asymmetrical geometry. Furthermore, compared with the ELT, it has a relatively smaller gate capacitance and smaller footprint. Therefore, the design limitations with regard to the limited W/L ratio in analog circuit design and the operating speed limitation with regard to the larger gate capacitance in the digital circuit design can be supplemented. Nevertheless, the proposed DGA n-MOSFET results in a slight operating speed degradation in the digital circuit compared with the conventional n-MOSFET.

نتیجه گیری

طرح n-MOSFET مقاوم به تابش جدید نامگذاری شده بعنوان یک لایه n-MOSFET DGA برای یک طراحی مدار مقاوم به تابش ارزیابی می شود. برای اهداف عملی، طرح n-MOSFET DGA ارائه شده دارای محدودیت هایی با توجه به نسبت W/L و هندسه نامتقارن نیست. علاوه بر این، در مقایسه با ELT، این دارای ظرفیت خازنی گیت نسبتاً کوچکتر و ردپای کوچکتر است. بنابراین، محدودیت های طراحی با توجه به نسبت W/L محدود شده در طراحی مدار آنالوگ و محدودیت سرعت عملیاتی با توجه به خازن گیت بزرگتر در طراحی مدار دیجیتال می تواند تکمیل شود. با اینحال، n-MOSFET DGA ارائه شده در کاهش سرعت عملیاتی جزئی در مدار دیجیتال در مقایسه با n-MOSFET معمولی نتیجه می دهد.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.